

02;09

## Интерференция при туннельной ионизации электрона, связанного двумя короткодействующими потенциалами

© П.А. Головинский<sup>1,2</sup>, А.А. Дробышев<sup>1</sup><sup>1</sup> Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж<sup>2</sup> Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный

E-mail: golovinski@bk.ru

Поступило в Редакцию 3 августа 2016 г.

Рассмотрена туннельная ионизация электрона, связанного двумя дельта-потенциалами, под действием постоянного электрического поля. Получены распределения плотности электронного тока для двух разных начальных состояний. Исследована зависимость эмиссионного тока от ориентации потенциалов относительно направления поля и расстояния между ними. Определены условия проявления интерференционных эффектов.

DOI: 10.21883/PJTF.2017.04.44304.16452

Метод потенциалов нулевого радиуса широко используется в атомной и ядерной физике, а также в физике конденсированных сред [1–3]. Важными приложениями метода стали описание нелинейной ионизации, генерации высоких гармоник в сильных лазерных полях [4–7] и простая модель туннельного эффекта в атомной микроскопии [8]. Известно аналитическое решение задачи о поляризации и туннельном отрыве электрона из короткодействующего потенциала атомарного отрицательного иона. Изучено также фоторазрушение отрицательных ионов в присутствии постоянного электрического поля разной конфигурации [9,10]. Используемый при этом единичный дельта-потенциал не описывает возможность делокализации электрона между несколькими областями притяжения, что на самом деле характерно для молекулярных и твердотельных систем.

Для задачи туннельной ионизации нейтральных молекул получило развитие обобщение метода сшивания асимптотик волновых функций

в параболических координатах на случай сферически несимметричных состояний [11–13]. Однако и здесь теория пока ограничивается рассмотрением локализованных состояний отдельных молекулярных орбиталей. Представление о локализованных состояниях, не учитывающее их возможную интерференцию, лежит в основе описания туннельных эффектов в наноструктурах [14,15]. В то же время теоретически показано, что делокализация существенно влияет на рассеяние аттосекундных лазерных импульсов двухатомными молекулярными анионами [16]. Выяснение возможной роли делокализации в формировании электронного тока при туннельной ионизации требует специального рассмотрения.

Задача о движении частицы в поле нескольких короткодействующих потенциалов без внешнего поля допускает проведение полного аналитического исследования [17]. При относительной близости потенциальных ям волновые функции в них перекрываются, и образуется общее протяженное состояние. Кроме того, такие системы обладают специфическим откликом на внешнее поле [18]. Нами рассмотрена картина интерференции электронных волн, образующихся при туннельном отрыве электрона из двухъямного потенциала, при разной ориентации поля и потенциала.

Задачу о движении частицы в поле нескольких дельта-потенциалов можно сформулировать на языке граничных условий, накладываемых на волновую функцию в точках расположения потенциалов. Для одиночного  $s$ -состояния с  $l = 0$  волновая функция  $\psi \sim r^{-1} \exp(-\alpha r)$ , и граничное условие принимает вид [2]

$$\left. \frac{d \ln(r\psi)}{dr} \right|_{r=0} = -\alpha, \quad (1)$$

где  $\alpha = \sqrt{-2E_0}$ ,  $E_0$  — энергия связи. Мы пользуемся атомной системой единиц, в которой  $|e| = m = \hbar = 1$ .

Для нескольких потенциалов их действие задается суммой одиночных потенциалов. Состояние частицы в поле двух одинаковых центров притяжения и внешнем электрическом поле с напряженностью  $F$  описывается стационарным уравнением Шредингера

$$\left( \varepsilon + \frac{1}{2} \nabla^2 + Fz \right) \psi(\mathbf{r}) = (V_1(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2)) \psi(\mathbf{r}), \quad (2)$$

где каждый потенциал [1,3]

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{2\pi}{\alpha} \delta(\mathbf{r}) \frac{\partial}{\partial r} r.$$

Решение, как и в задаче без поля [19], ищется в виде суперпозиции функций Грина

$$\psi(\mathbf{r}) = AG(\mathbf{r}, \mathbf{r}_1, \varepsilon) + BG(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \varepsilon),$$

где  $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_j, \varepsilon)$  — функции Грина с асимптотикой уходящей волны, удовлетворяющие уравнению (2) с заменой правой части на  $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)$ ,  $\mathbf{r}_1$  — радиус-вектор первого центра,  $\mathbf{r}_2$  — радиус-вектор второго центра (рис. 1, а). Функция Грина частицы, движущейся под действием постоянной силы, выражается через функции Эйри  $Ai(u)$  и  $Bi(u)$  [8]:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}', \varepsilon) = \frac{1}{2|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} (Ci(\chi_+)Ai'(\chi_-) - Ci'(\chi_+)Ai(\chi_-)),$$

$$\chi_{\pm} = -(2F)^{-2/3}(2\varepsilon + \mathbf{F}(\mathbf{r} + \mathbf{r}') \pm F|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|).$$

Функция  $Ci(u) = Bi(u) + iAi(u)$  имеет асимптотику уходящей волны при  $u \rightarrow \infty$ .

Учитывая граничные условия вида (1), получим систему уравнений для комплексной квазиэнергии  $\varepsilon = \text{Re}\varepsilon - i\Gamma/2$  и коэффициентов  $A$  и  $B$ :

$$\frac{1}{\rho_j \psi} \frac{\partial}{\partial \rho_j} (\rho_j \psi)_{\rho_j=0} = -\alpha,$$

где  $\rho_j = \mathbf{r} - \mathbf{r}_j$ ,  $j = 1, 2$ . Эту систему можно записать в виде [20]

$$\begin{pmatrix} b_+ & G(-\mathbf{R}/2, \mathbf{R}/2, \varepsilon) \\ G(\mathbf{R}/2, -\mathbf{R}/2, \varepsilon) & b_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0, \quad (3)$$

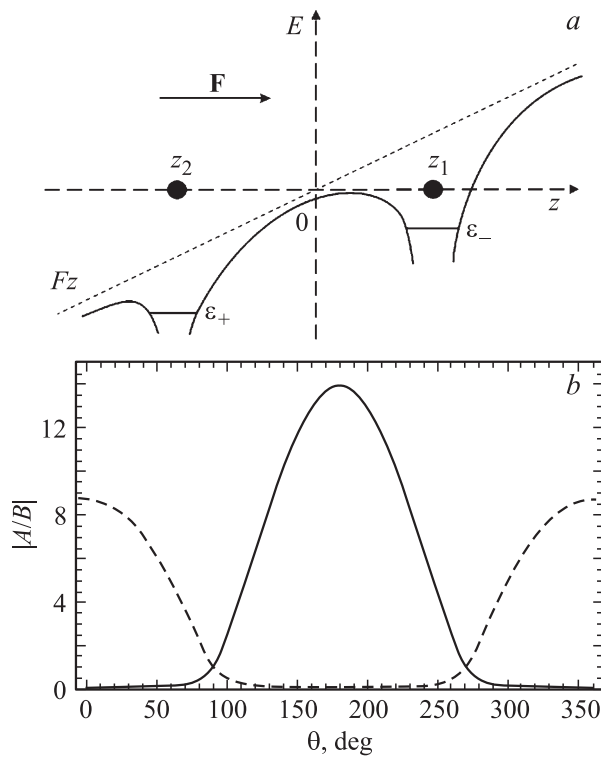
$$b_{\pm} = \frac{\pi}{(2F)^{1/3}} (Ai'(\xi_{\pm})Ci'(\xi_{\pm}) - \xi_{\pm}Ai(\xi_{\pm})Ci(\xi_{\pm})) + \alpha,$$

$$\xi_{\pm} = -\frac{2\varepsilon \pm FR \cos \theta}{(2F)^{2/3}},$$

где  $\mathbf{r}_1 = \mathbf{R}/2$ ,  $\mathbf{r}_2 = -\mathbf{R}/2$ ,  $R = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ . Система уравнений (3) имеет два решения, определяющих две волновые функции и два значения энергии  $\varepsilon_{\pm}$  соответствующих состояний с их ширинами, которые находятся из условия равенства детерминанта нулю.

Из системы уравнений (3) следует также связь коэффициентов  $A$  и  $B$ :

$$\frac{A}{B} = -\frac{2\pi G(-\mathbf{R}/2, \mathbf{R}/2, \varepsilon) + b_{\pm}}{2\pi G(\mathbf{R}/2, -\mathbf{R}/2, \varepsilon) + b_{\mp}} \Big|_{\varepsilon=\varepsilon_{\pm}}.$$



**Рис. 1.** Взаимное расположение центров (а) и зависимость отношения коэффициентов  $|A/B|$  от угла  $\theta$  (b). Сплошная линия — основное состояние, пунктир — возбужденное.

Для слабого электрического поля ( $F/\alpha^3 \ll 1$ ) сдвиги уровней и ширины вычислены ранее [18] и зависят от угла  $\theta$  между линией, соединяющей центры, и направлением электрического поля.

Наблюдаемой величиной в процессе туннельной ионизации является плотность электронного тока, пересекающего плоскость, перпендикулярную оси  $z$ , задаваемой направлением электрического поля:

$$j_z = \text{Im} \left( \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial z} \right).$$

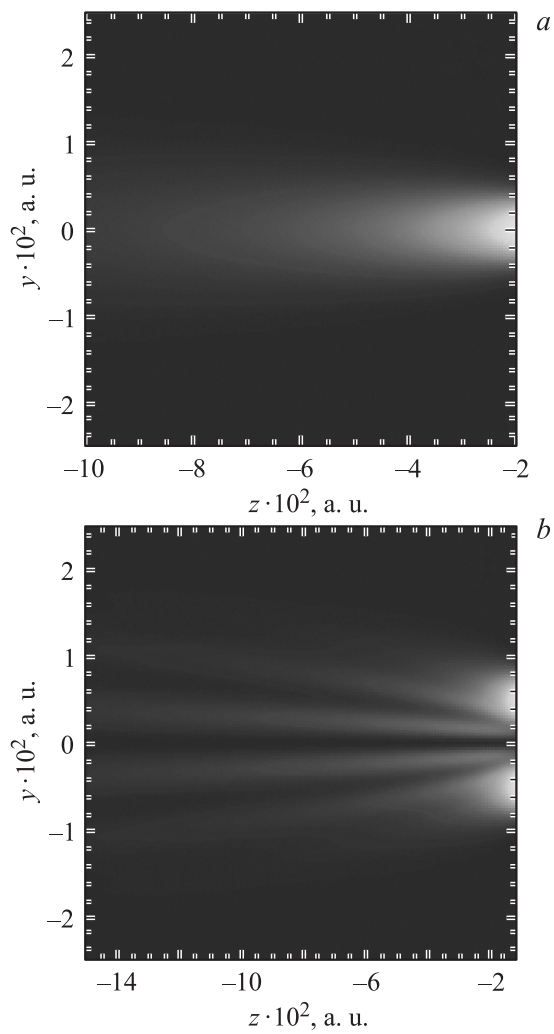
Пространственное распределение электронного тока зависит от угла  $\theta$  между осью, соединяющей центры, и направлением электрического поля, параметра  $\alpha|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ , характеризующего расстояние между центрами в сравнении с затуханием невозмущенной волновой функции, локализованной на отдельном центре, а также от параметра  $F/\alpha^3$ , задающего величину силы действия электрического поля по отношению к характерной силе, удерживающей частицу в потенциальной яме.

На рис. 1, *b* показан результат расчета отношения коэффициентов  $|A/B|$  в зависимости от угла  $\theta$  между  $\mathbf{R}$  и  $\mathbf{F}$  для значений параметров  $E_0 = 1 \text{ eV}$ ,  $F = 10^7 \text{ V/cm}$ ,  $R = 10 \text{ a.u.}$  Из представленных на рисунке зависимостей видно, что при  $\theta = \pi/2$  отношение коэффициентов в основном и возбужденном состояниях  $|A/B| = 1$ , что соответствует ситуации осевой симметрии. При ориентации системы параллельно полю ( $\theta = 0$ ) в основном состоянии  $|A/B| = 0.07$ , т.е. электрон фактически локализован на втором центре. В возбужденном состоянии, при  $\theta = 0$ , отношение коэффициентов  $|A/B| = 9$ , что соответствует локализации электрона на первом центре.

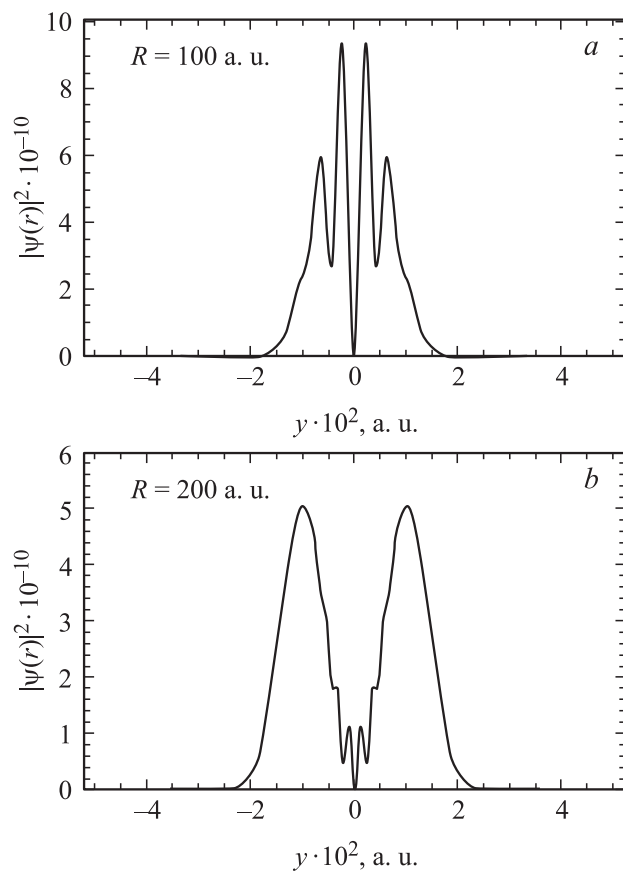
Имеются два предельных случая ориентации двухъямного потенциала относительно поля: параллельно полю и перпендикулярно полю. При параллельной ориентации ( $\theta = 0$ ) отношение коэффициентов  $A/B$  зависит от напряженности поля и расстояния между ямами. В этом случае внешнее поле вызывает делокализацию исходных состояний. Вычисления показывают, что увеличение расстояния и напряженности поля приводит к уменьшению смещения состояний, и электрон локализуется на одном из центров. В основном состоянии электрон локализуется на втором центре и туннелирует практически без взаимодействия с первым центром, а распределение туннельного тока аналогично току от одного точечного источника (рис. 2, *a*). В возбужденном состоянии электрон локализуется на первом центре и после туннелирования может рассеиваться на втором центре [20].

При ориентации двухъямного потенциала перпендикулярно полю ( $\theta = \pi/2$ ) отношение коэффициентов  $|A/B| = 1$ . Это означает, что волновая функция электрона является суперпозицией волновых функций в каждом из дельта-потенциалов, и электрон одинаково локализован на обоих центрах. В этом случае при ионизации электрона центры ведут себя как точечные когерентные источники (рис. 2, *b*). Внешнее поле в такой геометрии не вызывает делокализации исходных состояний.

На рис. 3 показан результат расчета поперечного распределения электронного тока при двух разных расстояниях между потенциалами.



**Рис. 2.** Распределение электронного тока из основного состояния при значении угла  $\theta = 0$  (a) и  $\theta = \pi/2$  (b). Напряженность поля  $F = 10^7 \text{ V/cm}$ ,  $E_0 = 1 \text{ eV}$ ,  $R = 100 \text{ a.u.}$



**Рис. 3.** Распределение электронного тока из основного состояния при разных значениях расстояния между потенциалами. Угол  $\theta$  равен  $\pi/2$ . Расстояние до экрана составляет 500 а.у.,  $E_0 = 1 \text{ eV}$ ,  $F = 10^7 \text{ V/cm}$ .

Сравнения представленных зависимостей демонстрирует, что при увеличении расстояния между центрами картина приближается к распределению тока от двух одинаковых независимых точечных источников.

Рассмотренное в работе явление интерференции электронных волн, образующихся при туннельной ионизации электрона из двухъямного

потенциала, существенно зависит от взаимной ориентации поля и потенциала, влияющей на степень локализации электрона возле разных центров. При ориентации двухъямной системы перпендикулярно полю распределение электронного тока эквивалентно распределению тока от двух одинаковых точечных когерентных источников. С ростом расстояния между центрами распределение приближается к картине, характерной для двух независимых источников. При наклонной ориентации потенциала, отличной от расположения перпендикулярно полю, делокализация исходных состояний увеличивается с ростом напряженности поля и расстояния между центрами.

Наблюдение описанных эффектов интерференции возможно в двухатомных молекулярных анионах [16]. Однако в таких экспериментах требуется решить дополнительные вопросы, связанные с выстраиванием оси молекулярного иона в заданном направлении и учетом или фиксацией его пространственного положения. В то же время современные технологии позволяют создавать наноэмиттеры из набора острых наноиглол [21,22], а также в виде нанопирамиды с вершиной из одного атома [23]. Близкое расположение таких наноразмерных источников будет обуславливать интерференционные проявления в токе эмиссии [24,25]. Это позволяет экспериментально проверить особенности пространственного распределения тока, предсказываемые предложенной моделью. Проведенные расчеты указывают также в целом на важность учета типа связи в молекулах при интерпретации результатов наблюдения туннельной ионизации электронов и необходимость проведения дополнительных исследований в этом направлении.

Работа выполнена в рамках ГЗ Министерства образования и науки РФ № 2014/19-2881.

## Список литературы

- [1] Демков Ю.Н., Островский В.Н. Метод потенциалов нулевого радиуса в атомной физике. Л.: ЛГУ, 1975. 240 с.
- [2] Базь А.И., Зельдович Я.Б., Переломов А.М. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. М.: Наука, 1971. 544 с.
- [3] Киржниц Д.А. Полевые методы теории многих частиц. М.: Либроком, 2010. 344 с.
- [4] Frolov M.V., Manakov N.L., Starace A.F. // Phys. Rev. A. 2008. V. 78 (6). P. 063418 (1–27).



- [5] Frolov M.V., Flegel A.V., Manakov N.L., Starace A.F. // Phys. Rev. A. 2007. V. 75 (6). P. 063407 (1–14).
- [6] Borzunov S.V., Frolov M.V., Ivanov M.Y. et al. // Phys. Rev. A. 2013. V. 88 (3). P. 033410 (1–18).
- [7] Frolov M.V., Knyazeva D.V., Manakov N.L. et al. // Phys. Rev. A. 2014. V. 89 (6). P. 063419 (1–18).
- [8] Donner B., Kleber M., Bracher C., Kreuzer H.J. // Am. J. Phys. 2005. V. 73 (8). P. 690–700.
- [9] Головинский П.А. // ЖЭТФ. 1997. Т. 112. В. 5. С. 1574–1583.
- [10] Golovinski P.A., Drobyshev A.A. // Proc. SPIE. 2010. V. 7993. P. 799311 (1–9).
- [11] Batishev P.A., Tolstikhin O.I., Morishita T. // Phys. Rev. A. 2010. V. 82. P. 023416 (1–14).
- [12] Jiang W.-Ch., Tolstikhin O.I., Peng L.Y., Gong Q. // Phys. Rev. A. 2012. V. 85. P. 023404 (1–15).
- [13] Tolstikhin O.I., Morishita T., Madsen L.B. // Phys. Rev. A. 2011. V. 84. P. 053423 (1–17).
- [14] Головинский П.А., Дробышев А.А. // ЖЭТФ. 2014. Т. 145. В. 6. С. 984–990.
- [15] Golovinski P.A., Drobyshev A.A. // JEMAA. 2014. V. 6. P. 8–14.
- [16] Есеев М.К., Матвеев В.И., Юлкова В.М. // ЖТФ. 2012. Т. 82. В. 11. С. 130–132.
- [17] Demkov Yu.N., Subramanian P. // Sov. Phys. JETP. 1970. V. 30. N 2. P. 381–383.
- [18] Dalidchik F.I., Slonim V.Z. // Sov. Phys. JETP. 1976. V. 43. N 1. P. 25–31.
- [19] Smirnov B.M., Firsov O.B. // Sov. Phys. JETP. 1965. V. 20. N 1. P. 156–160.
- [20] Борзунов С.В., Манаков Н.Л., Старас А.Ф., Фролов М.В. // ЖЭТФ. 2011. Т. 139. В. 5. С. 835–855.
- [21] Choi C.-H., Kim C.-J. // Nanotechnology. 2006. V. 17 (21). P. 5326–5333.
- [22] Verma I. P., Gautam S., Pal S. et al. // Defence Sci. J. 2008. V. 58 (5). P. 650–654.
- [23] Chang C.-C., Kuo H.-S., Hwang I.-S., Tsong T.T. // Nanotechnology. 2009. V. 20 (11). P. 115401 (6 p.).
- [24] Stratton J.C., Bilyeu T.T., Moon B., Moeck P. // Cryst. Res. Technol. 2014. V. 49 (9). P. 663–680.
- [25] Mándi G., Palotás K. // Phys. Rev. B. 2015. V. 91 (16). P. 165406 (1–12).